

указаны в картах рабочих режимов.

Применение транзисторов за пределами областей безопасных работ запрещается.



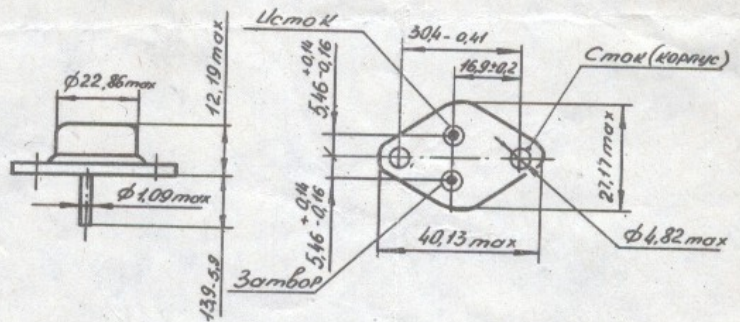
ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте осторожность
при работе
ПРИБОРЫ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ
К СТАТИЧЕСКОМУ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ



ТРАНЗИСТОРЫ КТ934А, КТ934Б, КТ934В

ЭТИКЕТКА

Мощные высоковольтные п-канальные кремниевые транзисторы со статической индукцией КТ934А, КТ934Б, КТ934В в металlostеклянном корпусе, предназначенные для применения в источниках вторичного электропитания и высоковольтных ключевых схемах.

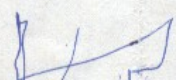


Масса не более 20 г

300
100
100

87
101
103

100
100



6

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
(при t° корп. = $(25 \pm 10)^{\circ}\text{C}$)

Наименование параметра	Н О Р М А					
	Группа А		Группа Б		Группа В	
	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Ток утечки сток-исток ($R_{зи} = 100 \text{ Ом}$, $U_{си} = 450 \text{ В}$), мА ($R_{зи} = 100 \text{ Ом}$, $U_{си} = 300 \text{ В}$), мА ($R_{зи} = 100 \text{ Ом}$, $U_{си} = 400 \text{ В}$), мА		3		3		3
Ток утечки затвор-исток ($U_{зи} = 5 \text{ В}$), мА		3		3		3
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии ($I_c = 5 \text{ А}$, $I_z = 1 \text{ А}$), Ом		0,1		0,1		0,1
Статический коэффициент усиления по току ($U_{си} = 5 \text{ В}$, $I_c = 5 \text{ А}$)	12		12		12	
Время спада ($U_{си} = 200 \text{ В}$, $I_c = 5 \text{ А}$, $I_z = 1 \text{ А}$) мкс		0,1		0,1		0,1

Драгоценных металлов не содержится

Цветных металлов не содержится

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы КП 934А, КП 934Б, КП 934В соответствуют техническим условиям 0.336.865 ТУ.

Штамп ОТК

Перепроверка произведена

дата

Штамп ОТК

УКАЗАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Допускается применение транзисторов, изготовленных в обычном климатическом исполнении, в аппаратуре, предназначенной для эксплуатации во всех климатических условиях, при покрытии приборов непосредственно в аппаратуре электроизоляционными лаками (в 3...4 слоя) с последующей сушкой.

2. Допустимое значение статического потенциала 1000 В.

3. Транзисторы пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки на подложке и пайке паяльником с применением оловянно-свинцовых и серебряных припоев.

При групповой пайке допускается:

нагрев в месте пайки до температуры $+190^{\circ}\text{C}$ в течение не более 30 с;

последующий нагрев в месте пайки до температуры не более $+230^{\circ}\text{C}$ в течение не более 15 с.

4. При монтаже транзисторов на теплоотвод необходимо соблюдать следующие требования:

для улучшения теплового баланса установку транзистора на радиатор необходимо осуществлять с помощью теплоотводящих паст;

запрещается припайка основания транзисторов к теплоотводу;

в случае необходимости изоляции корпуса транзистора от радиатора необходимо учитывать тепловое сопротивление изолирующей прокладки или пасты.

5. При разработке и изготовлении радиоаппаратуры необходимо обеспечить контроль и защиту транзисторов от воздействия мгновенных значений мощностей, токов и напряжений, которые могут возникать при переходных процессах (момент включения, выключения, короткое замыкание, нагрузка, изменение режимов работы аппаратуры при работе транзисторов совместно с реактивными элементами и т.д.)

Фактические значения этих режимов должны быть измерены и